

B-2 次の記述は、電界効果トランジスタ(FET)について述べたものである。□内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

- (1) トランジスタを大別するとバイポーラトランジスタとユニポーラトランジスタの二つがあり、このうちFETは ア トランジスタに属する。また、FETの構造が、金属 - 酸化膜(絶縁物) - 半導体により構成されているものを イ 形FETという。
- (2) シリコン半導体に代わり、化合物半導体の ウ を用いたFETは、電子移動度が エ、オ 特性が優れているため、マイクロ波の高出力増幅器等に広く用いられている。

ユニポーラ

3 7 5 4 6

- | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| 1 低周波 | 2 接合 | 3 ユニポーラ | 4 大きく | 5 ガリウムひ素(GaAs) |
| 6 高周波 | 7 MOS | 8 バイポーラ | 9 小さく | 10 ニッケルカドミウム(NiCd) |

